



Transistor Bipolar NPN / 160 MHz / 13.6 Vcc / 40 Watt / VHF

SKU: B2-223 Marca: TPL COMMUNICATIONS Categoría: Misceláneo

\$2,271.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Transistor bipolar NPN diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en banda VHF, optimizado para operación a 160 MHz con potencia de salida de 40 W. Su configuración de emisor común y alimentación a 13.6 Vcc lo hacen ideal para sistemas de comunicaciones profesionales. El diseño térmico eficiente permite manejar disipaciones de hasta 70 W manteniendo estabilidad en condiciones exigentes. La impedancia de entrada caracterizada (1.0 + j0.4 a 160 MHz) facilita el acoplamiento con etapas driver en diseños de amplificadores RF.

Características Principales

- Transistor bipolar NPN de alta frecuencia 160 MHz
- Potencia de salida de 40 W con 5 W de excitación
- Operación estable a 13.6 Vcc
- Diseño compacto con eficiencia térmica optimizada
- Rendimiento confiable en aplicaciones RF avanzadas
- Impedancia Zin 1.0 + j0.4 a 160 MHz

Especificaciones Técnicas

Tipología	Transistor bipolar NPN
Frecuencia	>160 MHz
Tensión alimentación	13.6 Vcc
Configuración	Emisor común
Aplicación	Comunicaciones VHF
Límites Máximos	
V _{CBO}	36 V
V _{CEO}	16 V
V _{CES}	36 V
E _{BO}	4.0 V
I _C	8.0 A
P _{DISS}	70 W
T _J	+200 °C
T _{sub} STG	-65 a +150 °C
Dinámicas	
P _{OUT}	40 W (f=160 MHz, P _{IN} =5.0 W, V _{CE} =13.6 V)
G _P	9 dB (f=160 MHz, P _{IN} =5.0 W, V _{sub} CE=13.6 V)
C _{OB}	95 pF (f=1 MHz, V _{sub} CB=15 V)
Estáticas	
BV _{CES}	36 V (I _C =15 mA, V _{sub} BE=0 mA)
BV _{CEO}	16 V (I _{sub} C=50 mA, I _{sub} B=...)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación estable en comunicaciones VHF
Característica 2	Eficiencia térmica optimizada en diseño compacto
Característica 3	Impedancia controlada Zin 1.0 + j0.4 a 160 MHz
Característica 4	Ganancia de potencia de 9 dB a frecuencia nominal
Característica 5	Disipación térmica de 70 W para alta demanda
Característica 6	Rango de temperatura de unión hasta +200 °C